

公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会主催

第 39 回シンポジウム

「二次元材料の合成と応用の最新動向と展望」

共催 CVD 研究会, Cat-CVD 研究会

日時：2023 年 11 月 14 日(火) 13:00～16:50 (予定)

場所：早稲田大学 西早稲田キャンパス 62 号館 W 棟 1 階大会議室 A,B

参加形態：対面 (+Zoom によるオンライン)

参加費(税込)：化学工学会 CVD 反応分科会法人賛助会員 (無料),

化学工学会 CVD 反応分科会個人会員 (3,000 円),

化学工学会 反応工学部会会員 (4,000 円), 化学工学会会員 (5,000 円),

CVD 研究会会員 (5,000 円), Cat-CVD 研究会会員 (5,000 円),

非会員 (12,000 円), 学生 (対面 2,000 円、オンライン無料)

申込方法：下記の Web サイトよりお申し込み下さい。また、doorkeeper.jp ドメインからのメールを受信可能としておいてください。

<https://cvd-hannoubunkakai.doorkeeper.jp/events/161056>

アクセスできない場合には、(1)氏名、(2)所属、(3)連絡先 E-mail、(4)参加資格(所属学会等)を明記のうえ、cvd@scej.org までメールにてお申し込み下さい。

申込締切：11 月 10 日 (金) 正午 厳守 (締め切り後の申し込みは一切できません。対面参加 70 名、オンライン参加 300 名の定員に達し次第、申し込み受付を終了いたします。)

問い合わせ先：CVD 反応分科会事務局 E-mail：cvd@scej.org

注意

- ・参加費はクレジットカードにてお支払いください。
- ・参加者による録画・録音は参加形態によらず一切禁止とします。
- ・講演内容のオンデマンド配信は行いません。
- ・会議 URL ならびに講演資料は参加申込者にのみ開催日前日にメールにてお送りします。
- ・懇親会は行いません。

開催趣旨

グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイドに代表される二次元物質・材料は、その新奇な物性により新たな半導体デバイスを実現し得ると期待されています。2004 年のグラフェンの報告より、物質群、合成・加工・実装技術、応用などが大きく進展しました。今回のシンポジウムでは、これまでの領域発展のレビューから最新の成果のご紹介までを頂き、二次元材料の実用化に向けた展望を議論します。

プログラム

12:30	開場	
13:00～13:05	開会挨拶	
13:05～13:45	「遷移金属ダイカルコゲナイドの合成と機能」	
		東京都立大学 宮田 耕充 氏
13:45～14:25	「Symmetry-directed Epitaxy Growth of 2D TMDs on C-plane Sapphire」	
		東京大学 Vincent Tung 氏
14:25～14:45	休憩	
14:45～15:25	「グラフェンの CVD 成長におけるリアルタイム観察技術とその活用」	
		NTT 物性科学基礎研究所 小川 友以 氏
15:25～16:05	「二次元材料/相転移材料ファンデルワールスヘテロ構造のデバイス応用」	
		関西大学 山本 真人 氏
16:05～16:45	(基調講演)「1 次元 2 次元半導体物質の戦略と CVD」	
		東北大学 齋藤 理一郎 氏
16:45～16:50	閉会挨拶	

シンポジウムオーガナイザー

杉目 恒志 (近畿大学)

玉置 直樹 (キオクシア株式会社)

野田 優 (早稲田大学)